

Расшифровка номера заказа продукции

W X X X X X X - X X X

0 = без эпитаксии

1 = 1 слой

2 = 2 слоя

3 = 3 слоя

4 = 4 слоя

5 = 5 слоев

0 = без эпитаксии

S = стандартная SiC эпитаксия

T = не стандартная SiC эпитаксия (толстые слои)

0 = одностор-я полировка, Si пов-ть готова к эп. росту

C = одностор-я полировка, C пов-ть готова к эп. росту

D = двустор-я полировка, Si пов-ть готова к эп. росту

G = двустор-я полировка, C пов-ть готова к эп. росту

1 = одностор-я хим.-мех. полир-а, Si пов-ть готова к эп. росту

2 = двустор-я хим.-мех. полир-а, C пов-ть готова к эп. росту

0 = стандартное кол-во дефектов

S = нормированное кол-во дефектов (селекция) - 16-30 микропор/см²

L = низкое содержание дефектов - ≤ 15 микропор/см²

U = ультранизкое содержание дефектов - ≤ 5 микропор/см²

Z = нулевое содержание дефектов - 0 микропор/см²

Код сопротивления (см. спецификацию)

0 = On-axis

3 = 3,5° Off-axis

4 = 4,0° Off-axis

8 = 8,0° Off-axis

D = 50,8 мм (2,0")

E = 76,2 мм (3,0")

F = 100,0 мм

Степень чистоты материала

P = для производственных целей

R = для экспериментальных целей

N = N-тип

S = полуизолирующие

T = полуизолирующие высокой степени чистоты

4 = политип 4H

6 = политип 6H

W = стандартные параметры